

# Содержание

● <b>Обзоры</b>	
<b>Лебедев М.В.</b> Модификация атомной и электронной структуры поверхности полупроводников $A^{III}B^V$ на границе с растворами электролитов . . . . .	587
● <b>Поверхность, границы раздела, тонкие пленки</b>	
<b>Бакулин А.В., Кулькова С.Е.</b> Первопринципное изучение реконструкций поверхности (001) полупроводников GaSb и InSb . . . . .	631
<b>Кривякин Г.К., Володин В.А., Камаев Г.Н., Попов А.А.</b> О влиянии гетерограниц и толщины на кинетику кристаллизации пленок аморфного германия . . . . .	643
<b>Лунин Л.С., Лунина М.Л., Алфимова Д.Л., Пащенко А.С., Пащенко О.С., Богатов Н.М.</b> Твердые растворы AlGaInSbAs, выращенные на подложках InAs методом зонной перекристаллизации градиентом температуры . . . . .	648
● <b>Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления</b>	
<b>Николаев В.В., Иванов К.А., Морозов К.М., Белонковский А.В.</b> Метод матриц рассеяния для расчета спонтанной излучательной рекомбинации в структурах с цилиндрической симметрией . . . . .	654
<b>Давыдов С.Ю., Зубов А.В.</b> Гетероструктура 2D SiC/Si: электронные состояния и адсорбционная способность . . . . .	663
<b>Стовяга Е.Ю., Курдюков Д.А., Кириленко Д.А., Голубев В.Г.</b> Формирование наностержней GaN в монодисперсных сферических мезопористых частицах кремнезема . . . . .	670
<b>Panda S.R., Sahu A., Das S., Panda A.K., Sahu T.</b> Doping-Dependent Nonlinear Electron Mobility in GaAs/In <sub>x</sub> Ga <sub>1-x</sub> As Coupled Quantum-Well Pseudo-Morphic MODFET Structure . . . . .	676
● <b>Физика полупроводниковых приборов</b>	
<b>Куницына Е.В., Ройз М.А., Андреев И.А., Гребенщикова Е.А., Пивоварова А.А., Ahmetoglu (Afrailov) M., Лебедок Е.В., Микулич Р.Ю., Ильинская Н.Д., Яковлев Ю.П.</b> Фотодиоды для регистрации излучения квантово-размерных дисковых лазеров, работающих на модах шепчущей галереи (2.2–2.3 мкм) . . . . .	677
<b>Lin Y.-C., Niu J.-S., Liu W.-C., Tsai J.-H.</b> Investigation of Pd HfO <sub>2</sub>  AlGaIn GaN Enhancement-Mode High Electron Mobility Transistor with Sensitization, Activation, and Electroless-Plating Approaches . . . . .	684
● <b>Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур</b>	
<b>Юрасов Д.В., Байдакова Н.А., Яблонский А.Н., Новиков А.В.</b> Влияние условий роста и уровня легирования на кинетику люминесценции слоев Ge:Sb, выращенных на кремнии . . . . .	685
<b>Mahmoodnia H., Salehi A., Mastelaro V.R.</b> GaAs Semiconductor Passivated by (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> S <sub>x</sub> : Analysis of Different Passivation Methods Using Electrical Characteristics and XPS Measurements . . . . .	691